

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014年6月26日(26.06.2014)



(10) 国際公開番号

WO 2014/097961 A1

- (51) 国際特許分類:
C23C 14/34 (2006.01) C22C 5/06 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/083334
- (22) 国際出願日: 2013年12月12日(12.12.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-279065 2012年12月21日(21.12.2012) JP
特願 2013-221977 2013年10月25日(25.10.2013) JP
- (71) 出願人: 三菱マテリアル株式会社(MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008117 東京都千代田区大手町一丁目3番2号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 野中 荘平(NONAKA Sohei); 〒6691339 兵庫県三田市テクノパーク12-6 三菱マテリアル株式会社 三田工場内 Hyogo (JP). 小見山 昌三(KOMIYAMA Shozo); 〒6691339 兵庫県三田市テクノパーク12-6 三菱マテリアル株式会社 三田工場内 Hyogo (JP).
- (74) 代理人: 志賀 正武, 外(SHIGA Masatake et al.); 〒1006620 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 Tokyo (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: Ag-In ALLOY SPUTTERING TARGET

(54) 発明の名称: Ag-In合金スパッタリングターゲット

(57) Abstract: The present invention provides an Ag-In alloy sputtering target for which abnormal discharge and splashing are reduced when sputtering to form a reflector electrode film from an Ag-In alloy. This Ag-In alloy sputtering target has a composition that contains 0.1-1.5 atom% of In, with the remainder consisting of Ag and unavoidable impurities. The content of each of the elements Si, Cr, Fe and Ni is 30 ppm or lower and the total content of these elements is 90 ppm or lower.

(57) 要約: 本発明は、Ag-In合金による反射電極膜を成膜するスパッタリング時に、異常放電やスプラッシュの発生を低減したAg-In合金スパッタリングターゲットを提供する。本発明のAg-In合金スパッタリングターゲットは、In: 0.1~1.5原子%を含有し、残部がAg及び不可避不純物からなる成分組成を有し、元素: Si、Cr、Fe及びNiの各々の含有量が、30ppm以下であり、さらには、その合計含有量が、90ppm以下である。



WO 2014/097961 A1